

GaAs 低噪声放大器芯片

关键指标

频率: 18~24GHz

增益: 20.5dB 噪声系数: 1.6dB

1dB 压缩点输出功率: 2.5dBm

电压/电流: +5V/12mA

芯片尺寸: 1.6mm×1mm×0.1mm

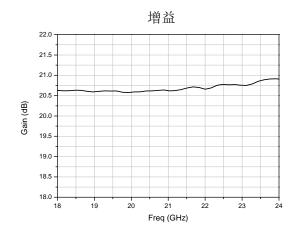
产品简介

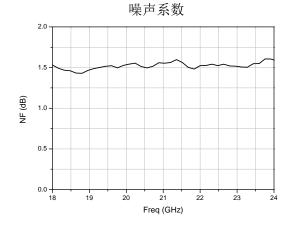
 ${
m HG117FB}$ 是一款 $18{\sim}24{
m GHz}$ 低噪声放大器芯片,增益为 $20.5{
m dB}$,噪声系数小于 $1.8{
m dB}$, $1{
m dB}$ 压缩点输出功率为 $2.5{
m dBm}$ 。

电性能(T_A=25℃,Vdd=+5V)

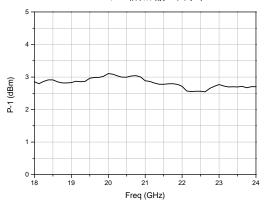
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	18~24		
增益(dB)	_	20.5	_
增益平坦度(dB)	_	±0.5	_
输入驻波	_	1.6	_
输出驻波	_	1.3	_
噪声系数(dB)	_	1.6	_
1dB 压缩点输出功率(dBm)	_	2.5	_
静态电流 (mA)	_	12	_

典型测试曲线

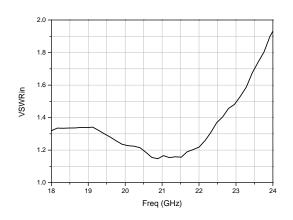




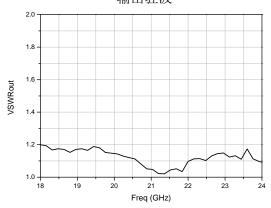
1dB 压缩点输出功率



输入驻波



输出驻波



绝对额定最大值

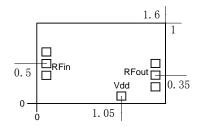
工作电压	+7V	
最大输入功率	+18dBm	
工作温度	-55°C∼125°C	
存储温度	-65℃~150℃	



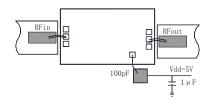
MICROARRAY TECHNOLOGIES 成都华光瑞芯微电子股份有限公司

GaAs 低噪声放大器芯片

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

- 1. 芯片在干燥、氮气环境中存储,在超净环境使用;
- 2. GaAs 材料较脆,不能触碰芯片表面,使用时必须小心;
- 3. 芯片用导电胶或合金烧结(合金温度不能超过300℃,时 间不能超过30秒), 使之充分接地;
- 4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合,建议金丝长度 250~400μm;
- 5. 芯片输入输出微波端均有隔直电容;
- 6. 芯片对静电敏感,在储存和使用过程中注意防静电。